

陶瓷电容器

对于一般的使用

SMD

C系列

特点

- 高电容已经通过精密技术实现奥希斯，允许使用多个较薄的陶瓷电介质层。
- 单片结构保证了优异的机械强度和可靠性。
- 高精度自动安装是通过促进保养的非常精确的尺寸公差。
- 由唯一的陶瓷和金属，这些电容亲韦迪极为可靠的性能，表现几乎没有甚至当经受极端温度降解。
- 低杂散电容确保了高符合标称值的UE，从而简化了电路设计过程。
- 低残留电感，保证了优异的频率特性。

产品标识

C 1005 CH 1H 100天 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 系列名称

(2) 尺寸L × W

0603	0.6 × 0.3mm
1005	1.0 × 0.5mm
1608	1.6 × 0.8mm
2012	2.0 × 1.25mm
3216	3.2 × 1.6mm

(3) 电容温度特性

第1类 (温度补偿)

温度特征	静电容量变化	温度范围
C0G	0±30ppm/°C	-55到+ 125°C

第2类 (温度稳定, 通用)

温度特征	静电容量变化	温度范围
X7R	±15%	-55到+ 125°C
X5R	±15%	-55至+ 85°C
Y5V	+22, -82%	-30至+ 85°C

(5) 额定容量

的电容被表示在3位代码，并在单位微微法拉 (pF) 的。

所述第一和第二位数字标识，第一和第二显著的电容的数字。

第三个数字标识的乘数。

R表示小数点。

010	1pF
100	10pF
102	1000pF
0R5	0.5pF

(6) 电容公差

符号	公差	适用电容范围
C	±0.25pF	在10pF以下
D	±0.5pF	
J	±5%	在10pF的
K	±10%	
M	±20%	
Z	+80, -20%	

(4) 额定电压Edc

0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1H	50V

(7) 包装形式

T	编带 (卷)
B	体积

